

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١١٣١٨

٩٩١٧٨



دانشگاه تربیت مدرس  
دانشکده فنی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مخابرات میدان

طراحی شبکه تغذیه آنتن مالتی بیم با استفاده از ساختارهای  
DGS

محسن مداح علی

استاد راهنما:

دکتر کیوان فرورقی

سازمان اطلاعات و ارتباطات  
مستشاران

۱۳۸۷ / ۰۵ / ۲۵

اردیبهشت ۸۷

۹۹۱۷۸



بسمه تعالی

### تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان

آقای محسن مداح علی پایان نامه ۹ واحدی خود را با عنوان طراحی آنتن مالتی بیم  
چپن باند در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۴ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و  
پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات پیشنهاد می  
کنند.

امضا	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	عضو هیات داوران
	دانشیار	دکتر کیوان فرورقی	استاد راهنما
	استاد	دکتر محمد حكاك	استاد ناظر
	استادیار	دکتر زهرا اطلس باف	استاد ناظر
	دانشیار	دکتر خلیج امیر حسینی	استاد ناظر
	استادیار	دکتر زهرا اطلس باف	مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)

این نسخه به عنوان نسخه نهایی پایان نامه / رساله مورد تایید است.

امضای استاد راهنما:

۹۹۷۸

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی که با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد ذیل را رعایت نمایند:

ماده ۱- حقوق مادی و معنوی پایان‌نامه‌ها / رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما مسئول مکاتبات مقاله باشد. تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه / رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان‌نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب انجام می‌شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می‌شود.

نام و نام خانوادگی

محسن سراج علی امضاء



## آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیت های علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته **مخابرات** است که در سال **۱۳۸۷** در دانشکده **مینی - محسن برق** دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار **کلیم اجناب آقای دکتر کیوان فروری**، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر \_\_\_\_\_ و مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر \_\_\_\_\_ از آن

دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.


ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده رابه عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب **محسن صراح علی** مقطع **کارشناسی ارشد** دانشجوی رشته **مخابرات**

تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: **محسن صراح علی**

تاریخ و امضا:  **۱۳۸۷، ۲/۱۰**

این پایان نامه با استفاده از حمایت‌های مادی و معنوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران طبق قرارداد TMU  
86-03-11 انجام شده است.

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

پدر و مادری که با زحمات بی‌دریغ و محبت‌های بی‌پایان‌شان مرا برای همیشه

شرمسار خود کرده‌اند.

## تشکر و قدردانی

اکنون که به لطف و کرم ایزد منان با ارائه‌ی این پایان‌نامه یکی دیگر از مراحل تحصیل را پشت سر می‌گذارم، حمد و سپاس فراوان خود را به درگاه با عظمتش تقدیم می‌کنم و توفیق به کارگیری این نعمت را در جهت کسب رضایت او و خدمت به بندگانش مسئلت دارم.

وظیفه‌ی خود می‌دانم که از زحمات استاد گرامی جناب آقای دکتر کیوان فرورقی که راهنمایی این پایان‌نامه را بر عهده گرفتند و مرا در اجرای آن صمیمانه و با گشاده‌رویی یاری رساندند، تشکر و قدردانی کنم. انجام مراحل تحقیق، جز به پشتوانه‌ی ایشان امکان‌پذیر نبود.

از اساتید محترم خود دکتر حکاک و دکتر اطلس باف که از راهنمایی و همکاری ایشان بهره‌ی فراوان برده‌ام سپاسگزارم. همچنین از زحمات دوست عزیز خود جناب آقای اسکوئی که در مراحل مختلف پایان‌نامه مرا همراهی کردند تشکر می‌کنم.

در پایان موفقیت خود را مرهون خانواده‌ی خود می‌بینم که صبر و گذشت ایشان مایه‌ی دلگرمی و دعایشان امیدبخش زندگیم خواهد بود.



## چکیده

در این پایان نامه ابتدا انواع DGS مطالعه و ویژگی های آنها به خصوص دوخاصیت Slow Wave و توانایی افزایش امپدانس آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در مرحله اول یک DGS با Q-Factor بالا طراحی و شبیه سازی می شود. در مرحله دوم با ترکیب خاصیت افزایش امپدانس DGS و مدل T خط انتقال، یک کاپلر 3-dB در فرکانس 1 GHz با مساحت ۳۵٪ نسبت به کاپلر ایدال طراحی و ساخته شد. از آنجا که هدف پایان نامه کاهش ابعاد ماتریس باتلر در فرکانس ۲/۴ GHz بود، ابعاد المانهای ماتریس از قبیل کاپلر 3-dB و کاپلر 0-dB را در فرکانس ۲/۴ GHz با کمک تکنیک قبلی کاهش داده، سپس با ترکیب چهار کاپلر 3-dB و یک کاپلر 0-dB کوچک شده و دو شیفت دهنده فاز، ماتریس باتلر کوچک شده در فرکانس ۲/۴ GHz با مساحتی برابر ۳۵٪ مساحت ماتریس عادی طراحی و ساخته می شود. نتایج شبیه سازی و پیاده سازی ماتریس با یکدیگر مقایسه و نشان داده شده است که این نتایج توافق خوبی با هم دارند. پهنای باند ماتریس نهایی حدوداً 150 MHz می باشد که این میزان پهنای باند برای سیستمهای WLAN تحت استاندارد IEEE 802.11 b که پهنای باند 80MHz نیاز دارد، کاملاً کافی می باشد.

## کلید واژه

آنتن مالتی بیم، ماتریس باتلر، کاپلر 3-dB، کاپلر 0-dB، ساختارهای کم شده از صفحه زمین (DGS)

## فهرست مطالب

فصل اول مقدمه	۱
۱-۱- مقدمه ای بر مفهوم آنتن مالتی بیم	۲
۲-۱- انواع شکل دهنده های بیم (BFN)	۵
۱-۲-۱- BFN های ساخته شده با تقسیم کننده توان	۶
۲-۲-۱- ماتریس باتلر	۷
۳-۲-۱- ماتریس بلاس	۸
۴-۲-۱- لنز روتمن	۹
۳-۱- هدف از پایان نامه	۱۰
۴-۱- ساختار پایان نامه	۱۰
فصل دوم تئوری ماتریس باتلر و پیشرفت های آن	۱۱
۱-۲- مقدمه	۱۲
۲-۲- تئوری ماتریس باتلر	۱۳
۳-۲- کاربرد های ماتریس باتلر	۱۷
۴-۲- اصلاحات و پیشرفت های ماتریس باتلر	۱۸
۱-۴-۲- ساخت ماتریس باتلر کوچک شده پهن باند به کمک تکنیک چند لایه CPW	۱۸
۲-۴-۲- ماتریس باتلر میکرواستریپی پهن باند در باند X	۲۴
۳-۴-۲- ماتریس باتلر دو بانده برای کاربرد های WLAN	۲۸
فصل سوم DGS و کاربرد های آن	۳۰
۱-۳- مقدمه	۳۱

- ۳-۲- مفهوم DGS و مدار معادل آن ..... ۳۲
- ۳-۳- ویژگیها و خواص ساختار های DGS ..... ۳۷
- ۳-۴- انواع DGS ..... ۴۳
- ۳-۵- کاربردهای DGS ..... ۴۶
- ۳-۵-۱- ساخت فیلتر پایین گذر ..... ۴۶
- ۳-۵-۲- ساخت هایبرید Rat-Race ..... ۴۷
- ۳-۵-۳- کاربرد در تقویت کننده ..... ۴۸
- ۳-۵-۴- هایبرید ۹۰ درجه کوچک شده ..... ۴۹
- فصل چهارم پیاده سازی ماتریس باتلر کوچک شده در فرکانس ۲/۴ GHz ..... ۵۲
- ۴-۱- مقدمه ..... ۵۳
- ۴-۲- شبیه سازی انواع DGS و مقایسه آنها ..... ۵۴
- ۴-۳- طراحی E-Shape DGS ..... ۵۶
- ۴-۳-۱- تاثیر طول Slot میانی  $l_e$  ..... ۵۷
- ۴-۳-۲- تاثیر ضخامت Slot میانی  $t_e$  ..... ۵۸
- ۴-۳-۳- طراحی فیلتر باند نگذر ..... ۵۹
- ۴-۴- طراحی هایبرید کوچک شده با استفاده از خاصیت سلفی DGS ..... ۶۰
- ۴-۵- پیاده سازی هایبرید به کمک مدل T خط انتقال و DGS در فرکانس ۱ GHz ..... ۶۳
- ۴-۶- شبیه سازی هایبرید ۹۰ درجه در فرکانس ۲/۴ GHz ..... ۷۰
- ۴-۷- شبیه سازی کاپلر 0-dB در فرکانس ۲/۴ GHz ..... ۷۱
- ۴-۸- شبیه سازی و ساخت ماتریس باتلر ۴×۴ کوچک شده ..... ۷۳

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات.....	۷۸
۱-۵- طراحی ماتریس باتلر کوچک شده در فرکانس ۲/۴ GHz.....	۷۹
۲-۵- نتایج.....	۸۰
۳-۵- پیشنهادات.....	۸۰
۴-۵- انتشارات.....	۸۱
۱-۴-۵- مقالات مجله ای.....	۸۱
۲-۴-۵- مقالات کنفرانس.....	۸۲

## فهرست اشکال

- شکل (۱-۱) آنتن Simulsat C/Ku..... ۵
- شکل (۲-۱) شکل دهنده بیم با کمک تقسیم کننده توان..... ۷
- شکل (۳-۱) ساختار ماتریس باتلر..... ۷
- شکل (۴-۱) شکل دهنده بیم بلاس..... ۹
- شکل (۵-۱) لنز روتمن..... ۹
- شکل (۱-۲) شماتیک یک ماتریس باتلر  $4 \times 4$ ..... ۱۳
- شکل (۲-۲) شکل بیم های ماتریس باتلر..... ۱۵
- شکل (۳-۲) ساختار ماتریس باتلر  $8 \times 8$ ..... ۱۶
- شکل (۴-۲) شماتیک کاپلر طراحی شده با کمک خطوط چند لایه CPW..... ۱۹
- شکل (۵-۲) توزیع میدان الکتریکی در کاپلر الف)مود زوج ب)مود فرد..... ۲۰
- شکل (۶-۲) امپدانس مشخصه مود زوج و فرد به صورت تابعی از الف) S و G ب) S و W..... ۲۱
- شکل (۷-۲) امپدانس مشخصه مود فرد به صورت تابعی از S و G..... ۲۱
- شکل (۸-۲) ضریب کوپلینگ K..... ۲۲
- شکل (۹-۲) پاسخ فرکانسی کاپلر پیشنهادی..... ۲۲
- شکل (۱۰-۲) شماتیک نهایی ماتریس باتلر کوچک شده..... ۲۳
- شکل (۱۱-۲) نتایج اندازه گیری ماتریس باتلر..... ۲۳
- شکل (۱۲-۲) اختلاف فاز پورت های خروجی..... ۲۴
- شکل (۱۳-۲) شماتیک ماتریس باتلر پهن باند در باند X..... ۲۵
- شکل (۱۴-۲) نتایج شبیه سازی ماتریس باتلر پهن باند در باند X..... ۲۶

- شکل ۲-۱۵) اختلاف فاز پورت های خروجی..... ۲۷
- شکل ۲-۱۶) شماتیک ماتریس باتلر دو بانده..... ۲۸
- شکل ۲-۱۷) پاسخ فرکانسی ماتریس باتلر دو بانده..... ۲۹
- شکل ۳-۱) شماتیک خط انتقال به همراه یک Dumbbell DGS ( $a=b=4\text{mm}$ ,  $l=27.5\text{mm}$ )..... ۳۲
- شکل ۳-۲) پارامترهای S ساختار نشان داده شده در شکل (۳-۱)..... ۳۲
- شکل ۳-۳) نمودار تغییرات پاسخ فرکانسی به ازای مقادیر مختلف مساحت قسمت پهن Dumbbell DGS..... ۳۴
- شکل ۳-۴) نمودار تغییرات پاسخ فرکانسی به ازای مقادیر مختلف پهناى Slot..... ۳۵
- شکل ۳-۵) شماتیک مدار معادل DGS..... ۳۵
- شکل ۳-۶) الگوی فیلتر پایین گذر تک قطبی باترورث..... ۳۶
- شکل ۳-۷) مدار معادل خط انتقال در حضور DGS..... ۳۸
- شکل ۳-۸) دامنه  $S_{21}$  به ازای  $C=0.67\text{pF}$ ,  $L=1.33\text{nH}$ ..... ۳۹
- شکل ۳-۹) فاز  $S_{21}$  به ازای  $C=0.67\text{pF}$ ,  $L=1.33\text{nH}$ ..... ۳۹
- شکل ۳-۱۰) نسبت  $\beta/k$  برای یک خط انتقال با پنج T-Shape DGS..... ۴۰
- شکل ۳-۱۲) مدل خط انتقال بارگذاری شده با  $Z_0$  به طول  $\theta$ ..... ۴۱
- شکل ۳-۱۳) نتایج شبیه سازی خط انتقال ربع طول موج به همراه DGS..... ۴۲
- شکل ۳-۱۴) امپدانس مشخصه خط انتقال ربع طول موج به همراه DGS..... ۴۳
- شکل ۳-۱۵) شماتیک Quasi-Dumbbell DGS..... ۴۳
- شکل ۳-۱۶) شماتیک H-Shape DGS..... ۴۴
- شکل ۳-۱۷) شماتیک چند مدل از DGS های معرفی شده..... ۴۴

- شکل ۳-۱۸) شماتیک U-Shape DGS و V-Shape DGS ..... ۴۵
- شکل ۳-۱۹) پاسخ فرکانسی U-Shape DGS ..... ۴۵
- شکل ۳-۲۰) مدار معادل یک فیلتر پایین گذر سه قطبی ..... ۴۶
- شکل ۳-۲۱) نمای فیلتر طراحی شده به کمک DGS ..... ۴۷
- شکل ۳-۲۲) پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر سه قطبی ..... ۴۷
- شکل ۳-۲۳) شماتیک مدار Rat Race کوچک شده به کمک DGS ..... ۴۸
- شکل ۳-۲۴) نتایج ساخت Rat Race کوچک شده به کمک DGS ..... ۴۸
- شکل ۳-۲۵) شماتیک تقویت کننده عادی ..... ۴۹
- شکل ۳-۲۶) شماتیک تقویت کننده کوچک شده به کمک DGS ..... ۴۹
- شکل ۳-۲۷) مدار معادل خط انتقال ۹۰ درجه به کمک دو خط انتقال به طول  $\theta$  و یک سلف ..... ۵۰
- شکل ۳-۲۹) شماتیک هایبرید کوچک شده ..... ۵۰
- شکل ۳-۳۰) شماتیک هایبرید کوچک شده به کمک DGS ..... ۵۱
- شکل ۴-۱) شماتیک انواع DGS های شبیه سازی شده ..... ۵۴
- شکل ۴-۲) نمودار تغییرات فاز  $S_{21}$  خط انتقال  $\lambda/4$  در فرکانس ۲/۴ GHz به ازای DGS های مختلف ..... ۵۴
- شکل ۴-۳) شماتیک U-Shape DGS ..... ۵۵
- شکل ۴-۴) پاسخ فرکانسی U-Shape DGS ..... ۵۵
- شکل ۴-۵) شماتیک E-Shape DGS ..... ۵۶
- شکل ۴-۶) مدار معادل E-Shape DGS ..... ۵۶
- شکل ۴-۷) منحنی تغییرات پاسخ فرکانسی به ازای تغییر طول Slot میانی ( $l_e$ ) ..... ۵۷

- شکل ۴-۸) منحنی تغییرات پاسخ فرکانسی به ازای تغییر پهنای Slot میانی ( $t_e$ )..... ۵۹
- شکل ۴-۹) شماتیک فیلتر پایین گذر سه قطبی ..... ۵۹
- شکل ۴-۱۰) پارامترهای S فیلتر پایین گذر سه قطبی..... ۶۰
- شکل ۴-۱۱) مدل بکار رفته برای خط انتقال  $\lambda/4$  ..... ۶۱
- شکل ۴-۱۲) شماتیک هایبرید کوچک شده به کمک مدل دو سلفی..... ۶۲
- شکل ۴-۱۳) پاسخ فرکانسی هایبرید کوچک شده به کمک مدل دو سلفی ..... ۶۳
- شکل ۴-۱۴) مدل T خط انتقال ..... ۶۳
- شکل ۴-۱۵) منحنی تغییرات طول الکتریکی  $\theta_1$  بر حسب  $\theta_3$  به ازای مقادیر مختلف M..... ۶۵
- شکل ۴-۱۶) خط میکرواستریپ  $\lambda/4$  به همراه DGS در فرکانس ۱ گیگا هرتز..... ۶۶
- شکل ۴-۱۷) پارامترهای S خط میکرواستریپ  $\lambda/4$  به همراه DGS در فرکانس ۱ گیگا هرتز..... ۶۶
- شکل ۴-۱۸) تغییرات امپدانس مشخصه خط انتقال به همراه DGS..... ۶۶
- شکل ۴-۱۹) شماتیک هایبرید کوچک شده در فرکانس ۱ گیگا هرتز..... ۶۷
- شکل ۴-۲۰) نمای بالا و پایین هایبرید ساخته شده (الف) بالا، (ب) پایین ..... ۶۸
- شکل ۴-۲۱) نتایج شبیه سازی و پیاده سازی کاپلر 3-dB کوچک شده به کمک DGS..... ۶۹
- شکل ۴-۲۵) شماتیک هایبرید کوچک شده در فرکانس ۲/۴ GHz گیگا هرتز..... ۷۰
- شکل ۴-۲۶) پاسخ فرکانسی هایبرید کوچک شده در فرکانس ۲/۴ GHz..... ۷۱
- شکل ۴-۲۷) شماتیک کاپلر 0-dB..... ۷۱
- شکل ۴-۲۸) پاسخ فرکانسی کاپلر 0-dB در فرکانس ۲/۴ GHz..... ۷۲
- شکل ۴-۲۹) شماتیک کاپلر 0-dB کوچک شده..... ۷۲
- شکل ۴-۳۰) نتایج شبیه سازی کاپلر 0-dB کوچک شده..... ۷۳



- شکل ۴-۳۱) شماتیک ماتریس باتلر ساخته شده در فرکانس ۲/۴ GHz..... ۷۴
- شکل ۴-۳۲) نتایج شبیه سازی IL و RL ماتریس باتلر کوچک شده در فرکانس ۲/۴ GHz..... ۷۵
- شکل ۴-۳۳) نتایج پیاده سازی IL و RL ماتریس باتلر کوچک شده در فرکانس ۲/۴ GHz..... ۷۵
- شکل ۴-۳۴) اختلاف فاز پورت های مجاور خروجی به ازای تغذیه پورت ۱..... ۷۵
- شکل ۴-۳۵) اختلاف فاز پورت های مجاور خروجی به ازای تغذیه پورت ۲..... ۷۶
- شکل ۴-۳۶) نمای بیم‌های تولیدی توسط ماتریس باتلر ۴×۴..... ۷۷
- شکل ۴-۳۷) شماتیک ماتریس باتلر استاندارد..... ۷۷

## فهرست جداول

- جدول ۱-۲) پارامترهای آرایه ماتریس باتلر به ازای تعداد بیم های مختلف ..... ۱۶
- جدول ۲-۲) اختلاف فاز بین پورت های خروجی مجاور ..... ۲۹
- جدول ۱-۳) پارامترهای استخراج شده مدار معادل به ازای  $g=0.2 \text{ mm}$  ..... ۳۷
- جدول ۲-۳) پارامترهای استخراج شده مدار معادل به ازای  $a=b=2.5 \text{ mm}$  ..... ۳۷
- جدول ۱-۴) فاکتور Q و پارامترهای مدار معادل E-Shape DGS به ازای تغییرات طول Slot  
میانی ( $l_e$ ) ..... ۵۸
- جدول ۲-۴) فاکتور Q و پارامترهای مدار معادل U-Shape DGS ..... ۵۸
- جدول ۳-۴) فاکتور Q و پارامترهای مدار معادل E-Shape DGS به ازای تغییرات پهنای Slot  
میانی ( $t_e$ ) ..... ۵۹
- جدول ۴-۴) پارامترهای کاپلر 0-dB کوچک شده ..... ۷۲

## فصل اول

### مقدمه

## ۱-۱- مقدمه ای بر مفهوم آنتن مالتی بیم<sup>۱</sup>

در اکثر سیستمهای Wireless از دو روش مرسوم استفاده می شود، یکی استفاده از آنتن های Omni Directional و دیگری تقسیم بندی مناطق و استفاده از آنتن ها با پهنای بیم مشخص برای هر منطقه (Sectorized Antenna System). در این دو روش حتی اگر فقط یک کاربر در یک سلول باشد بیم آنتن ها کل آن سلول را می پوشانند و این باعث کاهش بازدهی سیستمهای WLAN می شود. از طرفی برای تامین نیاز روز افزون شبکه های WLAN و تامین نیاز کاربران باید ظرفیت شبکه های موبایل و بازدهی طیف فرکانسی مورد استفاده افزایش یابد. برای غلبه بر مشکلات بیان شده ایده Smart Antenna معرفی شده است. این آنتنها به دو دسته کلی تقسیم می شوند: شبکه های مالتی بیم ثابت<sup>۲</sup> و دیگری آنتن های آرایه ای<sup>۳</sup> و افقی<sup>۳</sup>.

---

<sup>۱</sup> Multi Beam Antenna

<sup>۲</sup> Fixed Multibeam Antenna

<sup>۳</sup> Adaptive Array Antenna